

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-85738

(P2001-85738A)

(43)公開日 平成13年3月30日(2001.3.30)

(51)Int.Cl.	識別記号	P I	テマート*(参考)
H 0 1 L 33/00		H 0 1 L 33/00	C 3 K 0 0 7 M 5 F 0 4 1
// H 0 5 B 33/10		H 0 5 B 33/10	
33/12		33/12	A
33/22		33/22	Z
審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 14 頁)			

(21)出願番号 特願平11-257583

(22)出願日 平成11年9月10日(1999.9.10)

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 谷野 友哉

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
ー株式会社内

(72)発明者 中山 典一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ  
ー株式会社内

(74)代理人 100080883

弁理士 松隈 秀盛

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 自発光素子およびその製造方法、照明装置、並びに2次元表示装置

(57)【要約】

【課題】 発光効率を向上させることができる自発光素子を提供する。

【解決手段】 本発明の自発光素子4においては、サファイア基板6の上に、発光層に接する層(GaN)2、発光層1、p側GaN19、およびp電極3が形成されている。発光層1から発生した光は、発光層に接する層(GaN)2を通してサファイア基板6の方向に出射する。ここで、p電極3は、金属からなり反射機能を有している。また、発光層に接する層(GaN)2は、その側面が光を出射する方向に開いた形状を有している。さらに、発光層に接する層(GaN)2の側面の少なくとも1部は、発光層1からの光を全反射する形状を有している。

